



VGF、LEC InAs n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Sドーブ (n型)	Unドーブ (n型)	Znドーブ (p型)
サイズ	2インチ 3インチ		
面方位	(100) ± 0.5°		
	(311) A, B ± 0.5° (111) A, B ± 0.5°		

キャリア濃度	(cm ⁻³)	(4.0~8.0) × 10 ¹⁶ (1.0~5.0) × 10 ¹⁸	(1.0~5.0) × 10 ¹⁶	(1.0~5.0) × 10 ¹⁷ (1.0~3.0) × 10 ¹⁸
モビリティ	(cm ² /V.S)	15,000~25,000 7,000~12,000	≧ 23,000	200~350 100~250
EPD (Ave)	(cm ²)	≦ 3,000 ≦ 15,000	≦ 5,000 ≦ 15,000	— ≦ 15,000

直径	(mm)	50.8 ± 0.5	76.2 ± 0.5	—
厚さ	(μm)	500 ± 25	625 ± 25	—
TTV	(μm)	≦ 20	≦ 20	—
Warp	(μm)	≦ 15	≦ 15	—
OF長さ	(mm)	17.0 ± 1.0	22.0 ± 2.0	—
IF長さ	(mm)	7.0 ± 1.0	12.0 ± 1.0	—

レーザーマーク	オプション		
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)	
	裏面	エッチド / 鏡面研磨	
梱包形態	個別トレイ		

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。